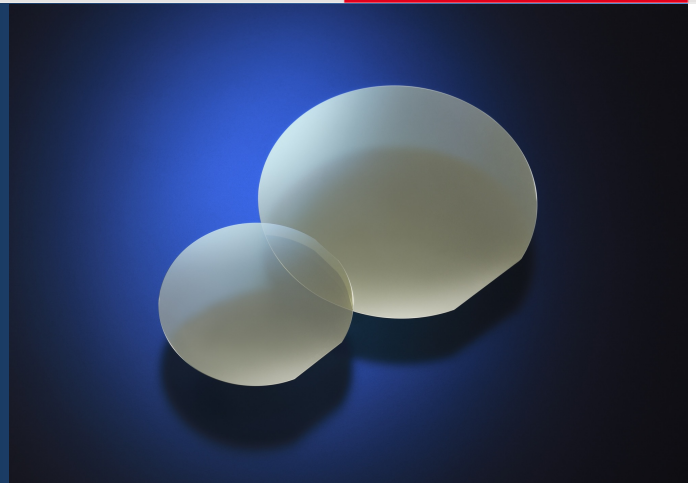


高精度研磨と特徴のあるCMP

パワー半導体用 SiC エピタキシャル ウェハー

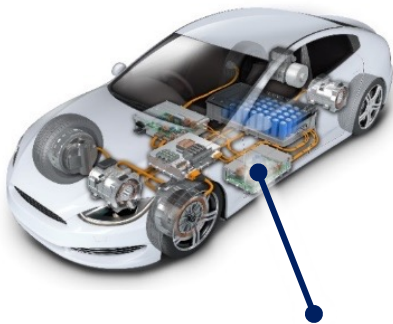


特長

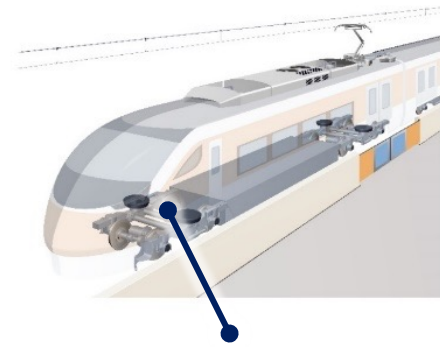
- ・ 高精度研磨技術による高い平坦性
- ・ 特徴のあるCMPによるウェハー表面潜傷の最小化
- ・ SiCデバイスの生産性の向上に貢献優れた機械強度と高熱伝導性を両立

用途

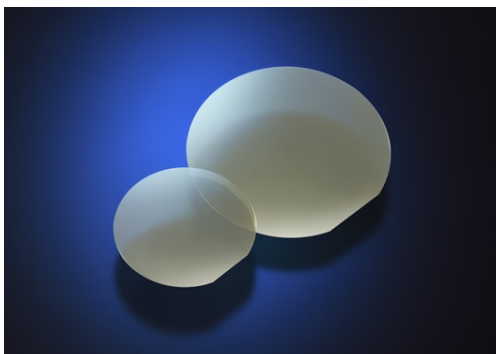
- ・ パワー半導体モジュール



・xEV用パワー半導体モジュール向け製品



・鉄道車両用パワー半導体モジュール向け製品



長年培ってきた高精度研磨技術と特徴のあるCMPにより当社のSiC エピタキシャルウェハーは、お客様のSiCデバイスの生産性向上に貢献します。

